シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

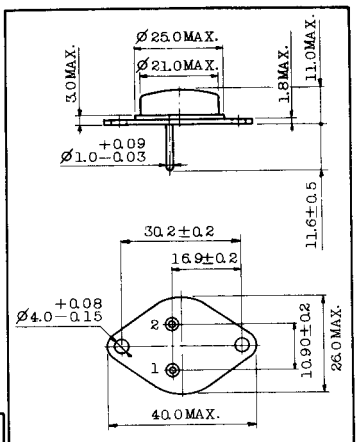
2SB531

○ 電力増幅用

○ Power Amplifier Applications.

- コレクタ損失が大きい。： $P_C = 50W$
- 高耐圧です。： $V_{CEO} = -100V$
- 2SD371とコンプリメンタリになります。
- 30W ハイファイオーディオアンプ出力段に最適です。
- Complementary to 2SD371.
- Recommended for 30W High-Fiderity Audio Frequency Amplifier Output Stage.

Unit in mm



1. BASE
2. EMITTER
COLLECTOR (CASE)

JEDEC	TO-3
EIAJ	TC-3, TB-3
TOSHIBA	2-21A1A

アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT No. AC73

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−100	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−6	A
エミッタ電流	I_E	6	A
コレクタ損失(Tc = 25℃)	P_C	50	W
接合温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−65～150	℃

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -50V$, $I_E = 0$	−	−	−100	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V$, $I_C = 0$	−	−	−100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1A$, $I_B = 0$	−100	−	−	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10mA$, $I_C = 0$	−5	−	−	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -5V$, $I_C = -1A$	40	−	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V$, $I_C = -4A$	20	−	−	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -4A$, $I_B = -0.4A$	−	−	−2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5V$, $I_C = -4A$	−	−	−1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5V$, $I_C = -1A$	−	8	−	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V$, $I_E = 0$, $f = 1MHz$	−	180	−	pF

Note : $h_{FE(1)}$区分／$h_{FE(1)}$ classification R : 40～80, O : 70～140, Y : 120～240